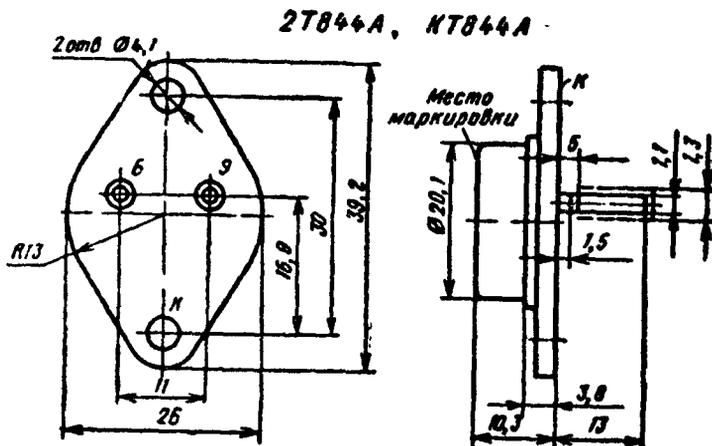


2Т844А, КТ844А

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры $n-p-n$ переключательные. Предназначены для применения в переключающих и импульсных устройствах. Корпус металлический со стеклянными изоляторами с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 20 г.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КЭ} = 3$ В, $I_K = 6$ А:

$T_n = +25^\circ\text{C}$	10...50
$T_n = T_{n, \text{макс}}$	8...150
$T = T_{\text{мин}}$	5...70

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_K = 0,5$ А, $f = 3$ МГц, не менее

2,4
3

Граничное напряжение при $I_K = 0,1$ А, $L = 40$ мГн, не менее

250 В

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_K = 6$ А, $I_B = 0,6$ А, не более

2,5 В
1,3 В

Напряжение насыщения база — эмиттер при $I_K = 6$ А, $I_B = 0,6$ А, не более

2,5 В
1,3 В

Время рассасывания при $U_{КЭ} = 100$ В, $I_K = 6$ А, $I_B = 1,2$ А, $U_{БЭ} = -4$ В, не более

2 мкс

Время спада при $U_{КЭ} = 100$ В, $I_K = 6$ А, $I_B = 1,2$ А, $U_{БЭ} = -4$ В, не более

0,3 мкс
0,15 мкс

Время нарастания при $U_{КЭ} = 100$ В, $I_K = 6$ А, $I_B = 1,2$ А, $U_{БЭ} = -4$ В, не более

0,3* мкс
0,15* мкс

Обратный ток коллектор — эмиттер при $U_{КЭ} = 250$ В, $R_{бэ} = 10$ Ом, не более:

$T_n = +25^\circ\text{C}$	3 мА
типичное значение	0,1 мА
$T_n = T_{n, \text{макс}}$ и $T = T_{\text{мин}}$	10 мА

Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = 4$ В, не более

20 мА
1 мА

Емкость коллекторного перехода при $U_{КЭ} = 10$ В, $f = 1$ МГц

160*...210*...300* п

Предельные эксплуатационные данные

Импульсное напряжение коллектор — эмиттер при $U_{БЭ} = 2$ В или $R_{бэ} = 10$ Ом	250 В
Постоянное напряжение база — эмиттер	4 В
Постоянный ток коллектора	10 А
Импульсный ток коллектора	20 А
Постоянный ток базы	4 А

Импульсный ток базы	7 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора ¹ с теплоотводом при $T_{ж} = T_{мин...} + 50^{\circ}C$	50 Вт
Температура р-п перехода	+175 ^o C
Температура окружающей среды:	
2Т844А	-60 ^o C... $T_{ж} = +125^{\circ}C$
КТ844А	-45 ^o C... $T_{ж} = +100^{\circ}C$

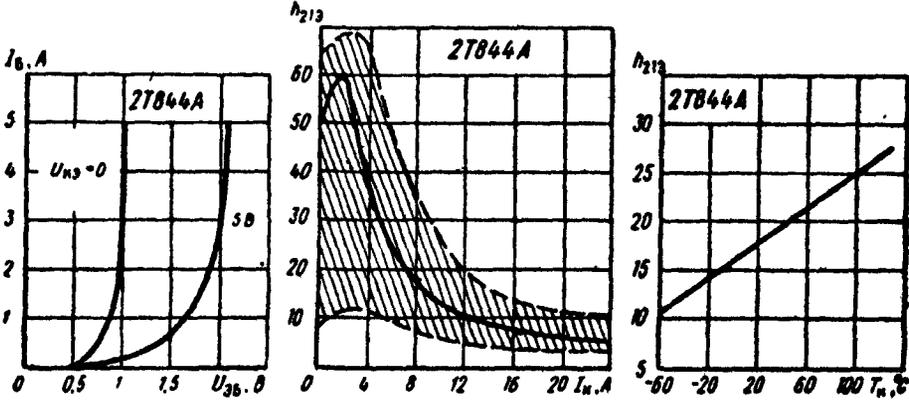
¹ При $T_{ж} > +50^{\circ}C$ $P_{K, макс}$ вычисляется по формуле

$$P_{K, макс} \text{ Вт} = (175 - T_{ж}) / R_{T(p-n)}$$

где $R_{T(p-n)}$ — определяется из области максимальных режимов.

Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса. При пайке температура корпуса не должна превышать +125^oC. При отсутствии контроля температуры корпуса пайка осуществляется паяльником с температурой +260^oC в течение не более 3 с.

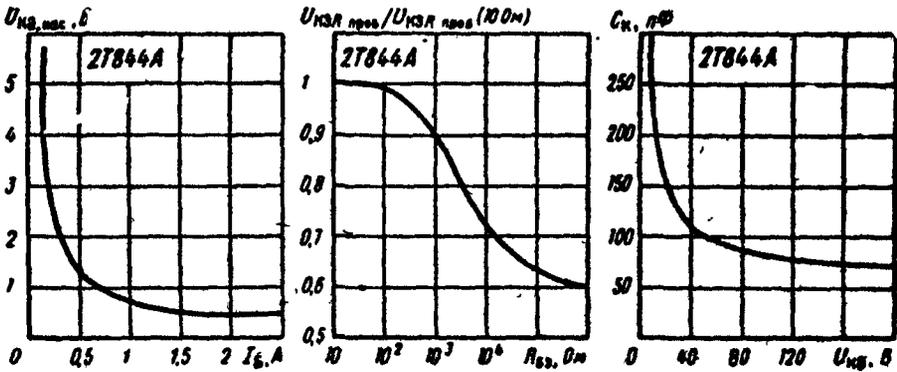
Допустимое значение статического потенциала 2000 В.



Входные характеристики

Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока коллектора

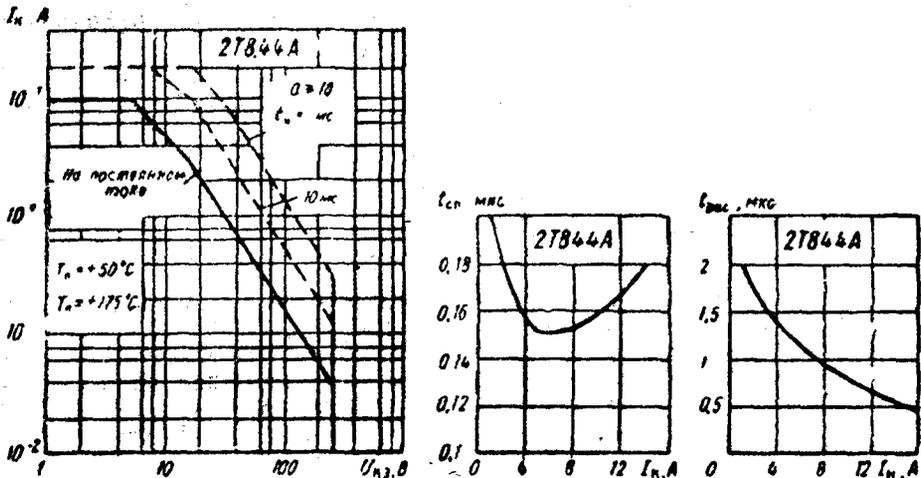
Зависимость статического коэффициента передачи тока от температуры корпуса



Зависимость напряжения насыщения коллектор — эмиттер от тока базы

Зависимость пробивного напряжения коллектор — эмиттер от сопротивления база — эмиттер

Зависимость емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор — база



Области максимальных режимов

Зависимость времени спада от тока коллектора

Зависимость времени рассасывания от тока коллектора